

中电海康“新型半导体存储器关键技术 研发与应用验证”课题启动会顺利召开

10月25日下午，由中电海康集团有限公司牵头承担的国家核高基重大专项“新型半导体存储器关键技术研发与应用验证”课题启动会在青山湖科技城科技与规划展览馆顺利召开。杭州市经信委电子信息处副处长方义务，临安区副区长、青山湖科技城管委会副主任庞保平，中电海康集团有限公司董事长陈宗年，中电海康集团有限公司总经理程瑜，浙江半导体行业协会常务副会长陈光磊，各参与单位专家以及中电海康集团相关人员参加了此次会议。

STT-MRAM 新型存储器具有高速、高密度、高可重写次数、非易失、抗恶劣环境等优势，在人工智能、物联网、未来计算机体系结构、穿戴设备、航空航天、汽车电子、医疗等领域具有独到的优势。对我国信息安全、自主可控具有重大的意义。该项目旨在开发新型高端存储器（STT-MRAM）的核心关键技术及应用验证，研制新型半导体存储器产品，快速积累相关核心知识产权，为我国半导体存储器技术和产业发展提供储备，为下一步自主可控新型处理器架构创新提供支撑。同时，利用所建核心技术工艺平台及自旋磁电子共性核心技术，开发高性能磁传感器技术与产品，推动我国高端高性能磁传感器技术研发与产业化。

会议上，陈宗年对各位与会的专家领导表示感谢，并指出该国家科技重大专项的立项和实施从各方面都体现出国家的战略需求，对所有参与单位都是一次重大的机遇。项目也是对国家存储器产业发展和实现自主可控的一个重大支撑，希望课题组按时按质按量完成这一国家重大科研任务。

